

XP133A1330SR

パワーMOS FET

■概要

XP133A1330SR は、低オン抵抗、超高速スイッチング特性を実現した N チャネルパワーMOS FET を 1 パッケージに 2 素子内蔵した複合タイプです。

スイッチング速度の高速化ができ、セットの高効率化、省エネルギー化を図ることが可能です。

パッケージは小型モールド SOP-8 を使用しており 高密度実装を可能にしています。

■用途

- ノートブック PC
- 携帯電話
- オンボード電源
- Li イオン電池

■特長

低オン抵抗 : Rds(on) = 0.03 Ω (Vgs = 4.5V)
 : Rds(on) = 0.04 Ω (Vgs = 2.5V)
 : Rds(on) = 0.07 Ω (Vgs = 1.5V)

超高速スイッチング

駆動電圧 : 1.5V 駆動

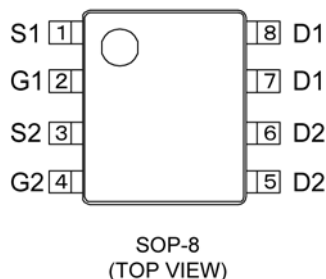
N チャネル パワーMOS FET

DMOS 構造

SOP-8 パッケージ

1 パッケージ 2 素子内蔵

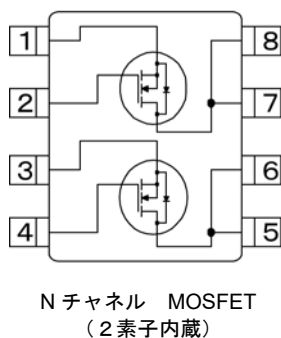
■端子配列



■端子説明

端子番号	端子名	機能
1	S1	ソース
2	G1	ゲート
3	S2	ソース
4	G2	ゲート
5~6	D2	ドレイン
7~8	D1	ドレイン

■等価回路



■絶対最大定格

Ta = 25°C

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	Vdss	20	V
ゲート・ソース間電圧	Vgss	±8	V
ドレイン電流 (DC)	Id	6	A
ドレイン電流 (パルス)	Idp	20	A
逆ドレイン電流	Idr	6	A
許容チャネル損失 *	Pd	2	W
チャネル温度	Tch	150	°C
保存温度	Tstg	-55~150	°C

*ガラスエポキシ基板実装

■電気的特性

DC 特性

Ta = 25°C

項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレイン遮断電流	I _{dss}	V _{ds} =20V, V _{gs} =0V	-	-	10	μA
ゲート・ソース間漏れ電流	I _{gss}	V _{gs} =±8V, V _{ds} =0V	-	-	±1	μA
ゲート・ソース間カットオフ電圧	V _{gs(off)}	I _d =1mA, V _{ds} =10V	0.5	-	1.2	V
ドレイン・ソース間オン抵抗 **	R _{ds(on)}	I _d =3A, V _{gs} =4.5V	-	0.025	0.030	Ω
		I _d =3A, V _{gs} =2.5V	-	0.030	0.040	Ω
		I _d =1A, V _{gs} =1.5V	-	0.045	0.070	Ω
順伝達アドミタンス **	Y _{fs}	I _d =3A, V _{ds} =10V	-	20	-	S
ボディドレインダイオード 順方向電圧	V _f	I _f =6A, V _{gs} =0V	-	0.85	1.1	V

** パルステスト

ダイナミック特性

Ta = 25°C

項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入力容量	C _{iss}	V _{ds} =10V, V _{gs} =0V f=1MHz	-	950	-	pF
出力容量	C _{oss}		-	430	-	pF
帰還容量	C _{rss}		-	180	-	pF

スイッチング特性

Ta = 25°C

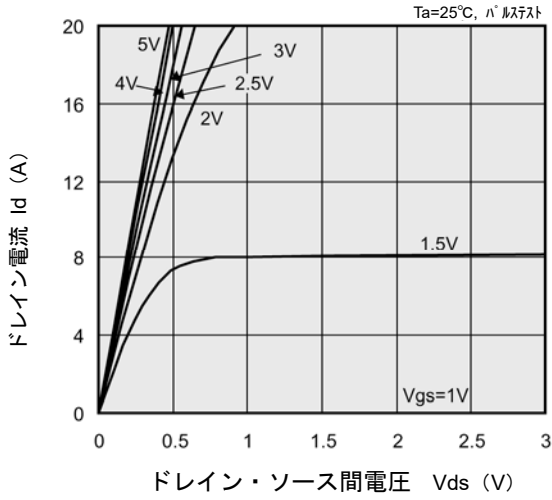
項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ターンオン遅延時間	t _{d (on)}	V _{gs} =5V, I _d =3A V _{dd} =10V	-	15	-	ns
上昇時間	t _r		-	20	-	ns
ターンオフ遅延時間	t _{d (off)}		-	80	-	ns
下降時間	t _f		-	15	-	ns

熱特性

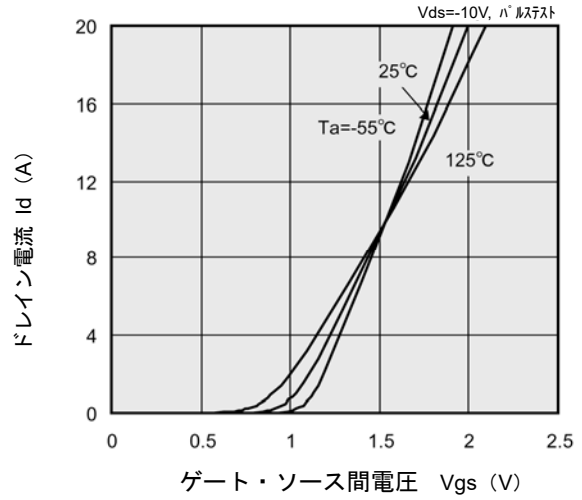
項目	記号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
熱抵抗(チャネルー周囲)	R _{th (ch-a)}	ガラスエポキシ基板実装	-	62.5	-	°C/W

■ 特性曲線

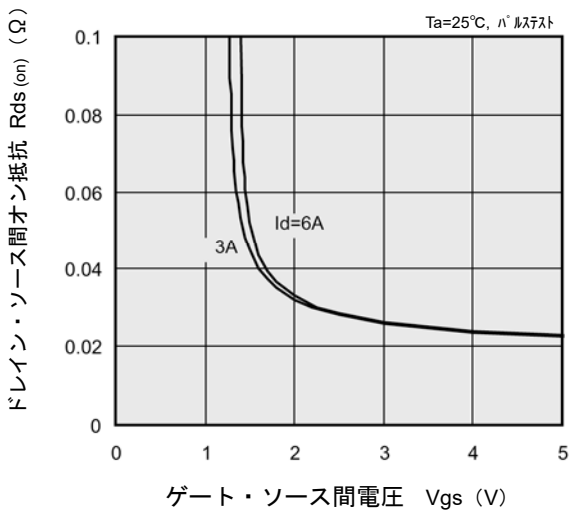
(1) ドレイン電流-ドレイン・ソース間電圧 特性例



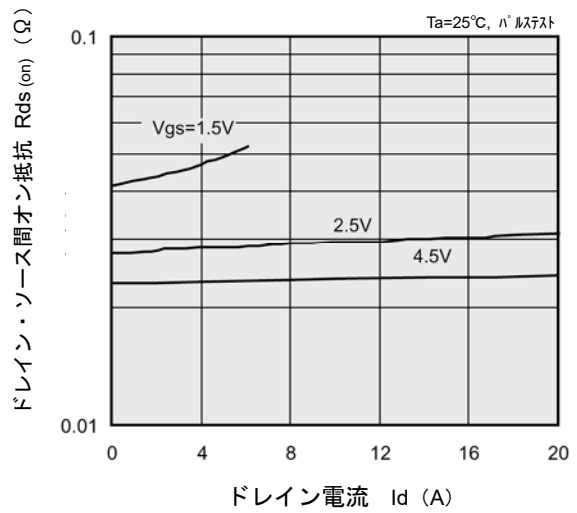
(2) ドレイン電流-ゲート・ソース間電圧 特性例



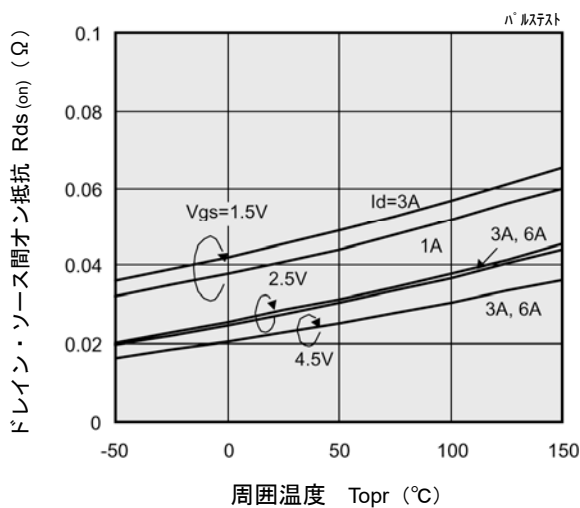
(3) ドレイン・ソース間オン抵抗-ゲート・ソース間電圧 特性例



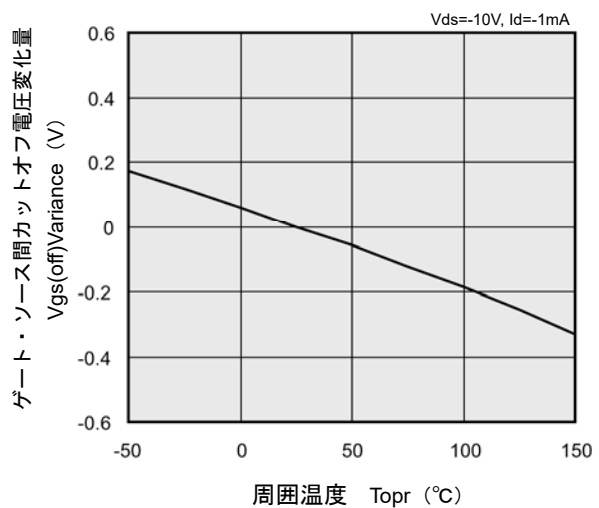
(4) ドレイン・ソース間オン抵抗-ドレイン電流 特性例



(5) ドレイン・ソース間オン抵抗-周囲温度 特性例

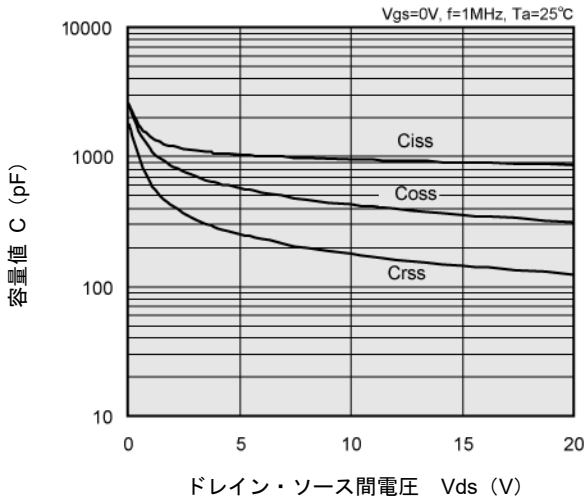


(6) ゲート・ソース間カットオフ電圧変化量-周囲温度 特性例

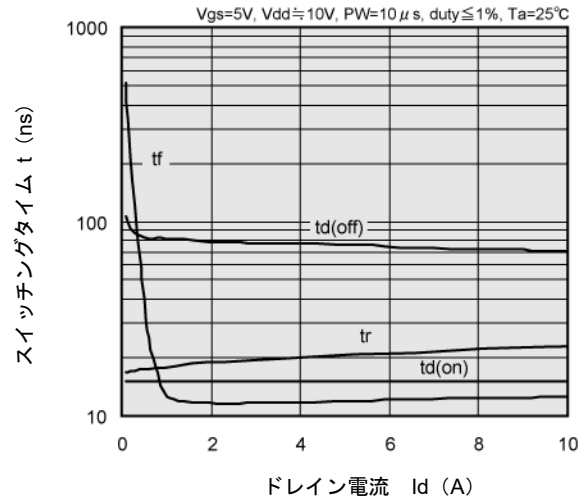


■ 特性曲線

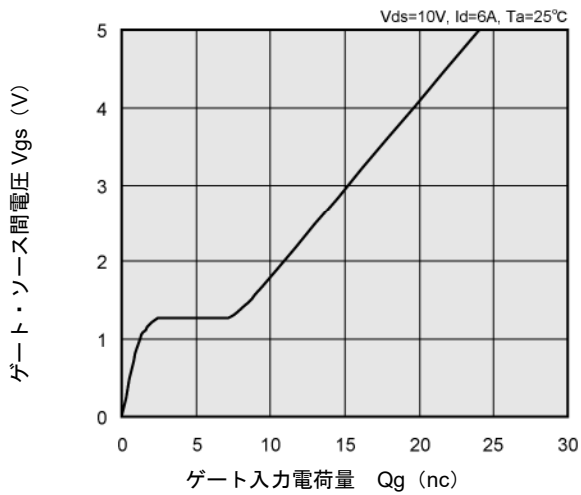
(7) 容量値—ドレイン・ソース間電圧 特性例



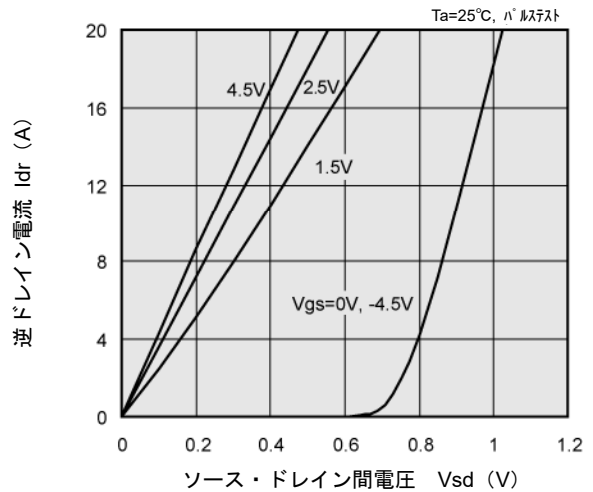
(8) スイッチングタイム—ドレイン電流 特性例



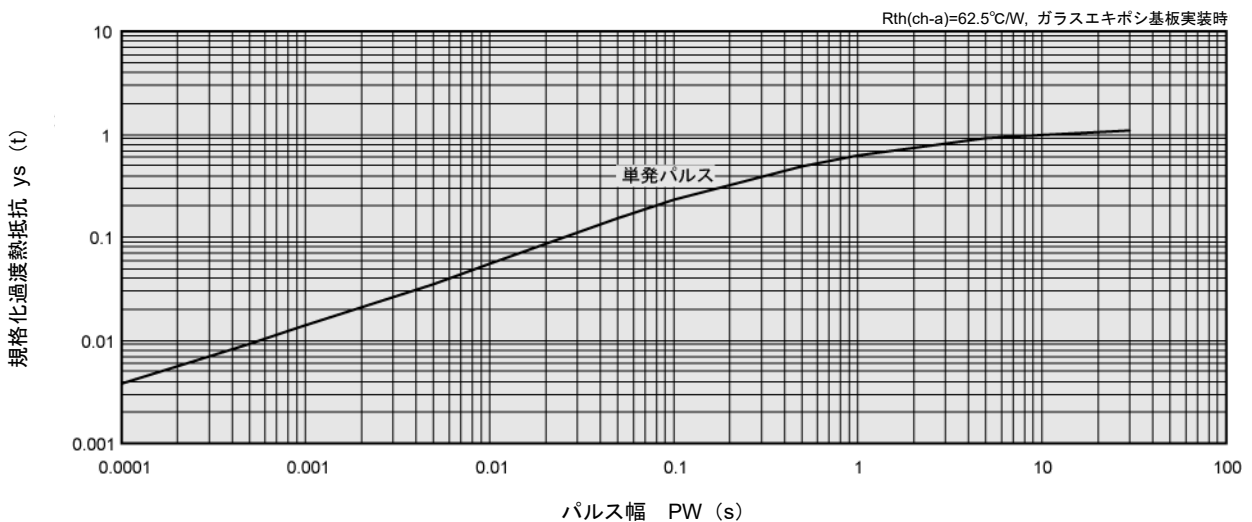
(9) ゲート・ソース間電圧—ゲート入力電荷量 特性例



(10) 逆ドレイン電流—ソース・ドレイン間電圧 特性例



(11) 規格化過渡熱抵抗—パルス幅 特性例



1. 本書に記載された内容(製品仕様、特性、データ等)は、改善のために予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、その最新情報を当社または当社代理店へお問い合わせ下さい。
2. 本書に記載された技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するものであり、工業所有権、その他の権利に対する保証または許諾するものではありません。
3. 本書に記載された製品は、通常の信頼度が要求される一般電子機器(情報機器、オーディオ/ビジュアル機器、計測機器、通信機器(端末)、ゲーム機器、パーソナルコンピュータおよびその周辺機器、家電製品等)用に設計・製造しております。
4. 本書に記載の製品を、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を脅かす恐れのある装置やシステム(原子力制御、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、生命維持装置を含む医療機器、各種安全装置など)へ使用する場合には、事前に当社へご連絡下さい。
5. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。
6. 保証値を超えた使用、誤った使用、不適切な使用等に起因する損害については、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
7. 本書に記載された内容を当社に無断で転載、複製することは、固くお断り致します。

トレックスセミコンダクター株式会社